

	НПЦ3.858.011		
Позиционное обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Микросхемы			
D1	LM2674N-ADJ	1	Корпус DIP-8
D2	Транзисторная оптопара 4N35	1	Корпус DIP-6
D3	ADM485AN	1	Корпус DIP-8
Конденсаторы			
C1	K50-35 (имп.) 63B-220 мкФ	1	
C2	Чип-конденсатор 1206 0,01 мкФ +-10%	1	
C3	K50-35 (имп.) 16B-100 мкФ	1	
C4	Чип-конденсатор 1206 0,22 мкФ +-10%	1	
Резисторы			
R1, R5	Чип-резистор 1206 4,7 кОм +-5%	2	
R2	Чип-резистор 1206 1,5 кОм +-5%	1	
R3	Чип-резистор 1206 330 Ом +-5%	1	
R4	Чип-резистор 1206 75 кОм +-5%	1	
Диоды полупроводниковые			
VD1, VD3, VD4...VD7	Диод Шоттки 1N5819	6	Корпус DO-41
VD2	Диод ограничительный SA36(CA)	1	P6KE39(CA)
VD8, VD9	Диод ограничительный SA6.0(CA)	2	

					НПЦ3.858.011 ПЭЗ							
Изм	Л	N докум	Подп	Дата	Модуль гальванической развязки МГР для МС6610.02 Перечень элементов			Лит		Лист	Л-в	
Разраб.		Семенихина		08.05.07							1	2
Провер.		Рябченко						НПЦм «СЕЛЕНА-К»				
Н. контр.												
Утв.		Вершков										
Инв.N подл		Подп. и дата		Взам. инв. N		Инв. N подл.		Подп. и дата				

Формат А4

	НПЦ3.858.011
--	--------------

Разъемы			
XP1	Вилка IDC-10MS двухрядная (для пайки на плату, прямая)	1	
L1	Дроссель ДПМ-0,4-100 мкГн	1	
FU1...FU3	Предохранитель самовосст. MF-R020 (0,2 А)	3	

					НПЦ3.858.011 ПЭЗ	Лист
Изм	Л	№ докум	Подп	Дата		2
Инв.№ подл		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.
						Подп. и дата

Формат А4